

Fortunato Pezzimenti ha conseguito la Laurea in Ingegneria Elettronica ed il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Elettronica presso l'Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria, rispettivamente nel maggio 2000 e nel marzo 2004.

Da gennaio 2006 egli è Ricercatore in Elettronica a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture e dell'Energia Sostenibile (DIIES), dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. La sua attività di ricerca ha riguardato il progetto e la simulazione numerica di transistor bipolari ad etero-giunzione (HBT) in GaAs e SiGe con emettitore sottile in silicio amorfo idrogenato (a-Si:H), lo sviluppo di blocchi logici aritmetici veloci come sommatore Manchester riconfigurabili, ed il progetto di microsensori compatibili con la tecnologia CMOS.

I suoi attuali interessi di ricerca includono sia il progetto e la caratterizzazione elettronica di dispositivi di potenza bipolari realizzati con semiconduttori ad ampia bandgap ed in particolare con il carburo di silicio 4H (4H-SiC) per applicazioni ad alta temperatura ed alta tensione, sia il progetto e la modellizzazione di celle solari multi giunzione ad alta efficienza. In relazione ai temi di ricerca presentati, egli è autore o coautore di circa 50 pubblicazioni su riviste internazionali o comunicazioni a congressi internazionali.

La sua attività didattica presso il DIIES dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria è inerente i corsi di Elettronica Digitale, Microelettronica e Progettazione VLSI.

Fortunato Pezzimenti received the Laurea and Ph.D. degrees in Electronic Engineering from the Mediterranean University of Reggio Calabria, Reggio Calabria, Italy, in May 2000 and March 2004, respectively.

Since January 2006, he has been an Assistant Professor of electronics with the Department of Information Engineering, Infrastructure and Sustainable Energy (DIIES), Mediterranean University of Reggio Calabria. His research has involved the design and numerical simulation analysis of GaAs and SiGe hetero-junction bipolar transistors (HBT) with an extremely thin hydrogenated amorphous silicon (a-Si:H) emitter, the development of fast and energy-efficient arithmetic building blocks, such as reconfigurable Manchester carry-bypass adders, and the design of miniature sensors that can be integrated in standard CMOS microchips.

His current research interests include both the design and electrical characterization of bipolar power devices based on wide bandgap semiconductors, in particular on silicon carbide 4H (4H-SiC) for high-temperature and high-voltage applications, and the design and modelling of high-efficiency multi-junction solar cells. Referring to the above research topics, he is author or co-author of about 50 publications on international journals and international conference proceedings.

His teaching activity with DIIES, Mediterranean University of Reggio Calabria, concerns the courses of Digital Electronics, Microelectronics, and VLSI design.